

(b)

The amended claim 4 recites an AlGaIN buffer semiconductor layer.

However, the original specification or drawing(s) only discloses an AlGaIN buffer semiconductor layer formed on the surface of a substrate.

Therefore, the AlGaIN buffer semiconductor layer is not disclosed in the original specification or drawing(s). Moreover, the amended claim 4 includes a feature other than those that can be derived directly and unambiguously from the original specification or drawing(s). Thus, the feature is not considered to be directly and unambiguously derived therefrom.

Consequently, the above amendment introduces new matter.

(c)

The amended claim 11 recites that a heat strain mitigating buffer layer is grown at 35 to 800°C.

However, the original specification or drawing(s) only discloses that a porous buffer layer, i.e., a core forming buffer layer is grown at 35 to 800°C (paragraph 8).

Therefore, the feature that a heat strain mitigating buffer layer is grown at 35 to 800°C is not disclosed in the original specification or drawing(s), nor is it considered to be directly and unambiguously derived therefrom.

Consequently, the above amendment introduces new matter.

It is clear that the features described in claims 1-11 of the amended

specification or drawing(s) do not fall within the scope of the features described in the specification or drawing(s) originally attached to the request of application. Therefore, patentability, such as novelty or inventive step, of the present invention has not been examined.

整理番号 A009400280

発送番号 552041

発送日 平成13年11月20日 1 / 2

拒絶理由通知書

特許出願の番号 平成 6 年 特許願 第038157号
起案日 平成13年11月12日
特許庁審査官 金高 敏康 9712 2K00
特許出願人代理人 鈴江 武彦 様
適用条文 第17条第2項

14.1.19

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

平成13年2月22日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条第2項に規定する要件を満たしていない。

記

(a)

補正された請求項1、4、8、9、11には、バッファ層が、多数の穴を有すること、平均膜厚3乃至10nmであること、が記載されている。

しかし、出願当初の明細書又は図面には、バッファ層が多孔質状であること（例えば、段落7）、平均膜厚が10nm未満であること（段落8）、のみに記載されている。

したがって、出願当初の明細書又は図面にはバッファ層が、多数の穴を有し、平均膜厚3乃至10nmであることは記載されておらず、かつ、直接的かつ一義的に導き出されるものとも認められない。

よって、上記補正は新規事項を追加するものである。

(b)

補正された請求項4には、AlGaINバッファ半導体層が記載されている。

しかし、出願当初の明細書又は図面には、基板表面に形成されたAlGaINバッファ半導体層のみに記載されている。

したがって、出願当初の明細書又は図面には、AlGaINバッファ半導体層は記載されておらず、かつ、出願当初の明細書又は図面から直接的かつ一義的に導き出すことができた事項以外のものも含有しているので、直接的かつ一義的に

導き出されるものとも認められない。

よって、上記補正は新規事項を追加するものである。

(c)

補正された請求項11には、熱歪緩和用バッファ層を35乃至800℃で成長することが記載されている。

しかし、出願当初の明細書又は図面には、多孔質状のバッファ層、すなわち、核形成用バッファ層を350～800℃で成長させることのみが記載されている(段落8)。

したがって、出願当初の明細書又は図面には、熱歪緩和用バッファ層を35乃至800℃で成長することは記載されておらず、かつ、直接的かつ一義的に導き出されるものとも認められない。

よって、上記補正は新規事項を追加するものである。

なお、当該補正がなされた明細書又は図面における請求項1～11に記載した事項は願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内にないことが明らかであるから、当該発明については新規性、進歩性等の特許要件についての審査を行っていない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせがございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第一部光デバイス(プロジェクトグループ)

金高(カネタカ) TEL. 03(3581)1101 内線 3202

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01S 5/00 - 5/50
 H01L 33/00

DB名 JICSTファイル(JOIS)

・先行技術文献

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。